## 長期利用課題報告

# テンダーX線タイコグラフィの基盤技術開発とその応用展開

東北大学 国際放射光イノベーション・スマート研究センター

高橋 幸生、阿部 真樹、石黒 志

住友ゴム工業株式会社 研究開発本部 分析センター 金子 房恵、岸本 浩通

公益財団法人高輝度光科学研究センター 情報技術推進室

松本 崇博

公益財団法人高輝度光科学研究センター ビームライン技術推進室

工藤 統吾

| (国)                | 理化学研究所 | 放射光科学研究センター |  |    |
|--------------------|--------|-------------|--|----|
| 次世代検出器開発チーム        |        |             |  | 宇記 |
| 公益財団法人高輝度光科学研究センター |        |             |  |    |
|                    |        |             |  |    |

## 放射光利用研究基盤センター 分光推進室 為則 雄祐

#### Abstract

本研究課題では、SPring-8 BL27SU においてテンダーX 線タイコグラフィ計測の基盤技術の開発に取り組ん だ。装置恒温化、ピンホールの精密加工、画像検出器 SOPHIAS-L の導入、照明光学系の改良など様々な技術開 発を行うことで計測精度が向上し、テンダーX 線タイコグラフィ計測システムを世界で初めて確立することに成 功した。また、同計測システムを用いて Ta テストチャートの測定を実施することで、幅 50 nm の構造を観察で きることを示した。さらに、硫黄(S)のK 端近傍において、硫黄変性ポリブチルメタクリレート粒子を測定す ることで、粒子内の硫黄化学状態を非破壊で可視化することに成功した。今後、開発したテンダーX 線タイコグ ラフィ計測システムを活用した様々な応用研究への展開が期待される。

1. はじめに

テンダーX線に明確な定義はないが、2~5 keVの 光子エネルギーを有するX線であるとされる。テンダ ーX線の特徴として、エネルギー領域内に硫黄やリン などをはじめとする様々な元素の吸収端が含まれる ため化学状態分析に有用なことや、比較的高い透過力 を活かして厚さ数 µm 程度のバルク試料内部の情報 を取得できることなどが挙げられる。テンダーX線領 域に吸収端を含む元素の多くは様々な材料や生物の 機能に関わっているため、試料内部における不均一な 化学状態の変化を観察することで、それらの機能が発 現するメカニズムの理解を深めることができる。テン ダーX線領域において実績のある顕微法としては、走 査型蛍光X線顕微法<sup>II</sup>、走査型透過X線顕微法<sup>I2</sup>、全 視野透過型 X 線顕微法<sup>33</sup>などが挙げられる。しかし、 これらの手法において空間分解能を決定する集光・結 像光学素子の作製精度が近年限界に近付きつつあり、 テンダーX 線顕微法の分解能はここ数年間 50 nm 程 度で停滞している<sup>14</sup>。X 線タイコグラフィは、コヒー レント X 線を試料に照射した際に観測される回折強 度パターンに対し、位相回復計算を実行することで試 料像を得る顕微法である。本手法において、レンズの 役割を計算機が担い、空間分解能が集光・結像素子の 加工精度の制限を受けないという利点を有している。 また、本手法を X 線吸収微細構造 (X-ray absorption fine structure, XAFS) 解析に拡張した X 線タイコグ ラフィを用いることで、試料の化学状態を数十 nm 分 解能で観察することが可能となる。しかしながら、コ ヒーレントイメージング計測に特化したビームライ ンが世界的に希少なテンダーX線領域において、X線 タイコグラフィの実証例は存在していなかった。本研 究課題では、SPring-8 BL27SUにおいてテンダーX線 領域におけるX線タイコグラフィ計測技術を開発<sup>60</sup>し、 軽元素イメージングに関する応用研究として、含硫黄 高分子材料中の硫黄の化学状態イメージング<sup>60</sup>を行っ た。

2. テンダーX線タイコグラフィ計測システムの開発
2-1. 計測装置の恒温化

X線タイコグラフィの試料像再構成では、試料への プローブ照射位置を既知情報として与えるが、その情 報と実際の照射位置との間に相違がある場合、像質が 低下する。この相違を生む原因の一つとして温度変化 による光学系の膨張・収縮が挙げられ、これを緩和す るためには光学系の恒温化が有効である。本研究では 図 1(a)の装置外観写真に示すように高調波カットミ ラーを含む装置全体をビニルテントで覆い、精密空調 機により 25℃の空気を送り込むことでビニルテント 内の温度変化を制御した。これにより、24 時間で



図1 (a)ビニルテントにより恒温化されている装置の外 観写真、(b)温度調整前後における試料面でのビー ム位置のドリフト量の時間変化。

外気温度が最大で0.8 K 変化しているのに対し、試料 チャンバー表面における温度変化は0.06 K 以内に抑 えられた。この恒温化がビーム位置の安定性に及ぼす 影響を評価するため、試料面におけるビームのドリフ ト量の時間変化を暗視野ナイフエッジスキャンによ り測定した。図1(b)に恒温化実施前後における水平・ 垂直方向へのビームドリフトの経時変化を示す。光軸 調整後3時間の測定において温度調整前は水平、垂直 方向のそれぞれに4.3 µm、8.9 µm のドリフトがあっ たのに対し、恒温化後ではそれぞれ920 nm、2.9 µm となり、恒温化により熱ドリフトが大幅に抑制された。

## 2-2. ピンホールの精密加工

前述の通り、今回の光学系においては入射X線をピ ンホールにより切り出すことで空間コヒーレンスを 確保している。ただし、使用するピンホールの内壁が平 滑でない場合、寄生散乱が発生し像質の低下を招く恐 れがある。2018B期において使用した市販の直径1 µm ピンホールの SEM 像ならびに 2.5 keV のX線を照射 して得られた回折強度パターンを図 2(a)に示す。箔の 表面は平滑とは言い難く、ピンホールの内壁にも凹凸 が多数存在していることが確認できる。回折強度パタ ーンにはフリンジの歪みやぼやけが生じているのが 分かる。そこで、平滑な壁面を有するピンホールを開 発・導入することができれば、試料入射X線のコヒー



図2 (a)市販のピンホール(左)とその回折強度パター ン(右)、(b)両面研磨した白金箔から作製したピン ホール(左)とその回折強度パターン(右)。

レンスを改善できるのではないかと考えた。株式会社 ティ・ディ・シーにより両面研磨処理が施された4µm 厚白金箔を用意し、これに集束イオンビームを用いて 直径1µmの円形開口を加工したピンホールを作製し た。このピンホールのSEM像ならびに回折強度パタ ーンを図2(b)に示す。箔表面の平滑性が大幅に改善し、 開口端部の形状も真円に近い形状を示している。回折 強度パターンには、ビジビリティにすぐれた同心円状 のフリンジが得られていることが分かる。

#### 2-3. 画像検出器 SOPHIAS-L の開発

X 線タイコグラフィにおける試料像の空間分解能 は、回折強度パターンの高空間周波数領域の信号対雑 音比に依存する。したがって、空間分解能を向上させ るためには、X線強度を増加させるか露光時間を長く する必要がある。露光時間を長くすることは計測のス ループットの低下につながるため X 線強度を向上さ せることが望ましく、光子計数率の大きな検出器が必 要となる。現在広く用いられている光子計数型検出器 の場合、2.5 keV で動作させようとすると既存検出器 に比べ1桁程度計数率を下げる、あるいは電力を1桁 増(画素面積1桁増)などが必要と見積もられ、テン ダーX線タイコグラフィに適用することは困難であ った。そこで理研の検出器グループは積分型の SOPHIAS<sup>17</sup>をテンダーX 線に対応できるように低ノ イズ化した SOPHIAS-L を新たに開発した。 SOPHIAS-L は SOPHIAS と同じく 1.9 メガピクセ ル、ピクセルサイズ 30 µm、撮像エリア 26.7 × 64.8 mm を持ち、2.5 keVのX線を1光子まで検出可能 かつ高い光子計数率を有する<sup>®</sup>。これにより、テンダ -X 線領域でのタイコグラフィ計測に適した画像検 出器が実現された。

#### 2-4. 光学系の改良

計測装置の性能を評価するため、2.5 keV における 200 nm 厚 Ta テストチャートのタイコグラフィ計測 を実施した。図 3(a)に計測に用いた光学系の模式図、 回折強度パターンの例、そして再構成された試料位相 像をそれぞれ示す。幅 50 nm の最小構造を再構成で きていることが分かる。しかし、像の全体に細かいア ーティファクトが存在しており、これは未だ試料入射 X 線のコヒーレンスが不十分であることを示唆して いる。このことは、回折強度パターン中に本来生じる べきでない試料の投影像が存在していることからも 裏付けられている。そこで、回折に寄与しないインコ ヒーレントな成分を取り除くために光学系に変更を 加えた。図3(b)に改良した光学系の模式図、回折強度 パターンの例、そして再構成された試料位相像をそれ ぞれ示す。この光学系は、ピンホールにより X 線を切 り出すところまでは同様だが、ピンホールー試料間に Fresnel zone plate (FZP) と Order-sorting aperture

(OSA)を新たに設置した。その際、ピンホールを通 り抜けた X 線が FZP の中心から約 50 µm 離れた位 置に照射されるように FZP を配置し (off-axis 配置)、 1 次光のみを選択的に切り出すように OSA を配置し た。回折強度パターンに試料の投影像が現れなくなり、 これは FZP と OSA により 1 次光のみを選択的に切 り出す過程でインコヒーレント成分が大幅に低減し たためだと考えられる。また、光学系の改良前後での 試料像を比較すると、明確な分解能の向上は見られな いものの、像全体に見られたアーティファクトが減少 して像の質が改善していることが分かる。



図 3 照明光学系の(a)改良前と(b)改良後における光学 系模式図(上)、200 nm 厚 Ta テストチャート測 定時の回折強度パターン(中)、再構成位相像(下)。

3. 硫黄化学状態イメージングへの応用

次に、テンダーX線タイコグラフィ計測による含硫 黄高分子粒子の硫黄化学状態イメージングに取り組 んだ。測定試料としては、ポリブチルメタクリレート と硫黄を混合・焼成して作製した硫黄変性ポリブチル メタクリレート (SPBMA) を用いた。なお、SPBMA は主に硫黄 (~49 wt.%) と炭素 (~47.5 wt.%)、酸 素 (~2.5 wt.%) から構成される。X 線タイコグラフ ィ計測の実施にあたり、SPBMA を SiN メンブレン上 に分散・担持させ、その中で孤立した単一粒子をS-K 端(~2.47 keV)近傍である 2.46~2.50 keV の 30 点で測定した。実際に測定した粒子の SEM 像を図 4(a)に示す。X線タイコグラフィにおける回折強度パ ターンの測定は試料を 500 nm 間隔で 11×11 点走査 することで行った。その際、試料に入射するフラック スは約2.1 × 10<sup>7</sup> photons/s であり、各走査点におけ る露光時間は5sとした。1エネルギー当たりの計測 に要する時間は約20分となり、全エネルギーでのト ータルの測定時間は約10時間となった。

図 4(b)、4(c)に 2.5 keV における測定で得られたピ クセルサイズ約 30 nm の試料吸収像および位相像を 示す。いずれの再構成像も SEM 像と矛盾しない形状 を示していることが確認できる。次に、各試料像中に 示した 3 点から取得した空間分解 XAFS スペクトル および空間分解位相スペクトルを図 4(d)、4(e)に示す。



図4 (a)試料 SEM 像、(b,c)2.5 keV において測定され た試料の再構成吸収像および位相像、各試料像中 に示した 3 点で得られた(d)空間分解 XAFS スペ クトルと(e)空間分解位相スペクトル。

なお、これらのスペクトルはいずれも XAFS スペクト ルのエッジジャンプ量 Δµt により規格化されている。 また、比較のため図 4(d)には、SAGA-LS BL16 で転換 電子収量法により測定された SPBMA の conventional XAFS スペクトルも示している。テンダーX 線タイコ グラフィにより得られた空間分解 XAFS スペクトル が conventional XAFS スペクトルと相似の形状を 有していることが確認でき、今回の計測精度の高さ を示している。なお、各吸収スペクトルが示している ~2.472, ~2.473 keV のピークは、SAGA-LS BL16 にて測定された硫黄と poly(3-hexyl thiophene)の conventional XAFS スペクトルが示すピークの位置 と一致したことから、S-S 結合と S-C 結合に由来する ものと考えられる。また、図4(e)に示した空間分解位 相スペクトルはいずれも相似形状を示しているが、ベ ースラインの値が異なっている。電子密度投影に比例 する位相シフト量を、硫黄量を反映した Δµt で規格 化した値は、硫黄以外の元素(主に炭素)が占める割 合を反映しているため、この結果は同一粒子内におい ても位置によって組成が異なっていることを示唆し ている。

試料の化学状態についてより定量的に評価するた め、空間分解 XAFS スペクトルのカーブフィッティン グ解析を行った。カーブフィッティングの例を図 5(a)



図 5 (a)空間分解 XAFS スペクトルのカーブフィッティ ング例、Δμt で規格化した(b)位相シフト、(c)S-S 結合ピーク強度、(d)S-C 結合ピーク強度のマップ。

に示す。フィッティングには Δµt を抽出する1つの 誤差関数、S-S 結合とS-C 結合に由来するピーク強度 を抽出する2つのローレンツ関数、そしてバックグラ ウンドを補正する 1 つの直線を用いた。図 5(b)-5(d) に位相シフト、S-S 結合強度、S-C 結合強度を Δμt に より規格化して得られた硫黄化学状態マップを示す。 位相シフトの分布は粒子の内側から外側にかけて強 度が高くなる傾向を示した。前述の通り組成の分布を 反映しているため、この結果は粒子の表面近傍領域ほ ど硫黄元素の割合が高く、バルク領域ほど硫黄以外の 元素(主に炭素)の割合が高いことを示唆している。 また、図 5(c)、5(d)に示した S-S 結合、S-C 結合の分 布は粒子の表面近傍にはS-S結合が豊富に存在する一 方でS-C結合が比較的少ないことを示唆しており、こ の結果は位相シフトの分布が示した元素分布の傾向 とも整合している。別に行った SEM-EDX 観察の結果、 硫黄が粒子表面に局在していたことから、今回の測 定・解析結果の妥当性が示された。

### 4. おわりに

本研究課題では、SPring-8 BL27SU においてテン ダーX 線タイコグラフィ計測の基盤技術の開発に取 り組んだ。装置恒温化、ピンホールの精密加工、二次 元検出器 SOPHIAS-L の導入、照明光学系の改良など 様々な技術開発を行うことで計測精度が向上し、テン ダーX 線タイコグラフィ計測システムを世界で初め て確立することに成功した。また、同計測システムを 用いて Ta テストチャートの測定を実施することで、 幅50 nmの構造を観察できることを示した。さらに、 硫黄 (S) の K 端近傍において、硫黄変性ポリブチル メタクリレート (SPBMA) 粒子を測定することで、粒 子内の硫黄化学状態を非破壊で可視化することに成 功した。今後、開発したテンダーX線タイコグラフィ 計測システムを活用した様々な応用研究への展開が 期待される。その一つがリチウム硫黄電池正極材料の 反応・劣化解析である。正極材料が充放電過程におい て示す硫黄化学状態の変化を観察することにより、硫 黄の反応経路や流出経路などの知見が得られる可能 性があり、その知見を材料設計に活かすことで電池の 高性能化への貢献が期待できる。

参考文献

- [1] Y. Tamenori, T. Yoshimura, N. T. Luan, H. Hasegawa, A. Suzuki *et al.*: J. Structural Biol. 186 (2014) 214-223.
- [2] Q. Xiao, A. Maclennan, Y. Hu, M. Hackett, P. Leinweber et al.: J. Synchrotron Rad. 24 (2017) 333-337.
- [3] M. Salomé, M. H. Lafage-Proust, L. Vico, D. Amblard, B. Kaulich *et al.*: *AIP Conf. Proc.* **507** (2000) 178-183.
- [4] M. A. Samarai, F. Meirer, C. Karunakaran, J. Wang, E. T. C. Vogt *et al.*: *J. Phys. Chem. C* **119** (2015) 2530-2536.
- [5] M. Abe, F. Kaneko, N. Ishiguro, T. Kudo, T. Matsumoto et al.: J. Synchrotron Rad. 28 (2021) 1610-1615.
- [6] M. Abe, F. Kaneko, N. Ishiguro, T. Kubo, F. Chujo *et al.*: *J. Phys. Chem. C* **126** (2022) 14047-14057.
- [7] T. Hatsui, M. Omodani, T. Kudo, K. Kobayashi, T. Imamura *et al.: Proceedings of the 2013 International Image Sensor Workshop (IISW)* (2013) Article No. 3.05. (12-16 June 2013, Snowbird, Utah, USA.)

## <u>高橋 幸生 TAKAHASHI Yukio</u>

東北大学 国際放射光イノベーション・スマート研究センター 〒980-8577 宮城県仙台市青葉区片平 2-1-1 TEL: 022-217-5166 e-mail: ytakahashi@tohoku.ac.jp

#### <u>阿部 真樹 ABE Masaki</u>

東北大学 国際放射光イノベーション・スマート研究センター 〒980-8577 宮城県仙台市青葉区片平 2-1-1 TEL:022-217-5818 e-mail:masaki.abe.p1@dc.tohoku.ac.jp

#### 石黒 志 ISHIGURO Nozomu

東北大学 国際放射光イノベーション・スマート研究センター 〒980-8577 宮城県仙台市青葉区片平 2-1-1 TEL: 022-217-5818 e-mail: nozomu.ishiguro.c1@tohoku.ac.jp

#### 金子 房恵 KANEKO Fusae

住友ゴム工業株式会社 研究開発本部 分析センター 〒651-0071 兵庫県神戸市中央区筒井町 2-1-1 TEL:078-265-5688 e-mail:f-kaneko.az@srigroup.co.jp

#### <u>岸本 浩通 KISHIMOTO Hiroyuki</u>

住友ゴム工業株式会社 研究開発本部 分析センター 〒651-0071 兵庫県神戸市中央区筒井町 2-1-1 TEL:078-265-5688 e-mail:h-kishimoto.az@srigroup.co.jp

## <u>松本 崇博 MATSUMOTO Takahiro</u>

(公財)高輝度光科学研究センター 情報技術推進室
〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都 1-1-1
TEL:0791-58-0833
e-mail:matumot@spring8.or.jp

## <u>工藤 統吾 KUDO Togo</u>

(公財)高輝度光科学研究センター ビームライン技術推進室
〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都 1-1-1
TEL:0791-58-0833
e-mail:kudo@spring8.or.jp

## 初井 宇記 HATSUI Takaki

(国)理化学研究所 放射光科学研究センター
次世代検出器開発チーム
〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都 1-1-1
TEL:0791-58-0833
e-mail: hatsui@spring8.or.jp

## <u>為則 雄祐 TAMENORI Yusuke</u>

(公財)高輝度光科学研究センター
放射光利用研究基盤センター 分光推進室
〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都 1-1-1
TEL:0791-58-0833
e-mail:tamenori@spring8.or.jp